表面電離器から ECR イオン源への Li イオンの輸送

2004.12.03 森信 俊平 rev. 2005.03.27 森信 俊平

Optical pumping 法によって偏極された Li 原子は、表面電離器内の高温酸化タング ステン板上でイオン化される。イオンはその後 19 kV の電圧(ECR イオン源内のプラ ズマ対地電圧)で加速され(加速後の電位は大地電位)、適当な偏向器によって水平 に偏向され、ECR イオン源に軸に沿って入射される。高効率で Li イオンをプラズマ 領域に入射させるためには、Li イオンをプラズマ領域入射直前まで減速せず、効率良 く輸送することが重要である。

表面電離器からイオンは鉛直上方に引き出され、適当な加速管で加速された後、静 電偏向器によって 90°偏向されて ECR イオン源の軸に乗せられる。本稿では、イオ ンの経るこれら各段階でイオンの挙動を考察し、高効率でイオンを ECR イオン源に 入射する可能性を検討することとする。

1. 表面電離器の構造とイオン輸送 geometry

1.1. geometry

次のような表面電離器とその後に続く Li イオン輸送系 geometry を前提とする。

- 1) 磁場の領域は図 1.1 のようにイオン引き出し電極 を中心とし、半径 *R* の円形とする。
- 2)磁場の向きは紙面に垂直であり、強度 B はこの領域内で一様である。(実際には、領域周辺で B が減衰する事による効果は、有効磁場境界(EFB)と fringing field 補正を考慮することで扱う。)
- 3) イオンは引き出し電極と平行に置かれた酸化タン グステン板から相対電圧 Vのグリッドを用いて上方 45°の方向にに引き出される。
- 4)引き出されたイオンは更に磁場によって 45° 偏向 されて鉛直上方(下流)に向い、その後 19 kV の電 圧で加速される。



図 1.1 のイオン引き出し部で、1 価のイオンについて 図 1.1. 表面電離器と磁場領域 その質量を *M* [a.m.u.]とし、上記の geometry を前提とすれば、

$$B\rho = 1.44 \times 10^2 \sqrt{MV} \qquad [G \cdot cm] \tag{1.1}$$

 $R = 2\rho \sin(\pi/8)$

である。更に磁場境界の法線と軌道は $\pi/8$ の角度を持つ。磁場強度は減偏極を最小化 する要請から決めるとすると、 ρ (即ちR)が定まれば、Vは一意に定まる。

1.2. イオンの引き出し角度

酸化タングステン板から磁場中で電界によってイオンを引き出す場合、その引き出 し角度を推定しておく。引き出し電極はグリッドであるとする。ただし、グリッドワ イヤ近傍の局所電場による散乱は次節で考慮することとし、ここでは考えない。酸化 タングステン板上に x 軸、直角方向に y 軸を取る。

電界は y 軸方向に強度 E、磁界は x-y 面に垂直に強度 B であると考えると、

$$m\frac{dv_x}{dt} = ev_y B, \qquad m\frac{dv_y}{dt} = eE - ev_x B$$
(1.2)

が成り立つ。t=0 で $v_x = v_y = 0$ の条件下でこれを解いて

$$v_x = \frac{E}{B}(1 - \cos\frac{eB}{m}t), \qquad v_y = \frac{E}{B}\sin\frac{eB}{m}t$$
(1.3)

が得られ、y=d (グリッド面)での粒子の軌道角度は

$$\frac{v_x}{v_y} = \frac{1 - \cos\frac{eB}{m}t}{\sin\frac{eB}{m}t} = \sqrt{\frac{\frac{eB^2d}{mE}}{2 - \frac{eB^2d}{mE}}}$$
(1.4)

となる。

電界 E はタングステン板と距離 d 離れて酸化タングステン板に平行に置いたグリッドに電圧を印可することによって与えられるとし、加速後の粒子の磁場内軌道半径を ρ とすると

$$\frac{v_x}{v_y} = \sqrt{\frac{\left(d/\rho\right)^2}{1 - \left(d/\rho\right)^2}} \approx \frac{d}{\rho}$$
(1.5)

となる。d = 5 mm, $\rho = 100 \text{ mm}$ の場合、粒子軌道は酸化タングステン板の法線と 50 mr 程度の傾きを持つことになる。これによる磁場領域の出口でのビームシフトは位置で 3.0 mm、角度で 50 mr の程度となり、調節を要する大きさとなる。

1.3. グリッドワイヤによる散乱

グリッドワイヤの表面には局所的に強い電界が発生するため、粒子引き出し角度は 前節の推定値の周りに広がりを持つ。

太さcのワイヤを等間隔(間隔a)に配置したグリッドについては、電界は等角写像の方法により解析的に解くことが出来る。(例えば、P.M.Morse and H.Feshbach,

Methods of Theoretical Physics, 1953, McGraw-Hill や W.R.Smythe, Static and Dynamic Electricity, 1950, McGraw-Hill 参照) ただし、ワイヤ表面で厳密に境界条件を満たす解 は数値計算がやっかいであるから、ここでは c << a と考え、無限に細いグリッドワ イヤの作る場を考え、ワイヤ周囲のほぼ円筒形の等電位面をワイヤ表面と見なすこと とする。

1.2.節と同様な座標系で、x-y面に垂直に $x = \pm a/2, \pm 2a/2, \pm 3a/2, ...の位置に一様に帯$ 電したワイヤを張り、今度は<math>y = 0をグリッド面と考える。ワイヤによるポテンシア ルyは

$$\psi = \frac{aeE}{4\pi} \left\{ \log 4 \left[\cos^2 \frac{\pi x}{a} + \sinh^2 \frac{\pi y}{a} \right] - \frac{2\pi}{a} y \right\} + K$$
(1.6)

で与えられる。ただし、グリッド面から十分離れた場所での電場強度はy > 0なら0、 y < 0ならy-方向にEとした。Kはワイヤ表面の電位を与えれば決まる定数である。電 場のx方向成分 E_x は

$$E_x = \frac{E}{2} \frac{\cos\frac{\pi x}{a} \sin\frac{\pi x}{a}}{\cos^2\frac{\pi x}{a} + \sinh^2\frac{\pi y}{a}}$$
(1.7)

で与えられることになる。

x方向電場*E*_xはグリッド面近傍の狭いy範囲に限られるから、y-方向に加速されたイオンは*E*_xによりパルス的にx-方向に力を受ける。その結果、グリッド領域を出たイオン軌道とy軸のなす角度aは、x-方向の力積とy-方向運動量との比として

$$\alpha \approx \frac{v_x}{v_y} \approx \frac{e}{m v_y^2} \int_{-\infty}^{+\infty} E_x dy = \frac{e}{2eV} (E \cdot x) = \frac{x}{2d}$$
(1.8)

となる。ただし、Vはイオン加速電圧、dは加速ギャップである。この式で取り扱われるxの範囲は

$$-\frac{1}{2}(a-c) < x < \frac{1}{2}(a-c)$$
(1.9)

としてよいから、グリッドによる散乱で生じるイオンの角度幅は

$$\Delta \alpha = \frac{a-c}{2d} \approx \frac{a}{2d} \quad (\mathbf{X} \wr \mathbf{t} \pm \frac{a}{4d}) \tag{1.10}$$

であることが期待される。 $d \approx 5 \text{ mm}$ 、 $a \approx 0.5 \text{ mm}$ とすると、 $\Delta \alpha$ は $\pm 25 \text{ mr}$ であり、必ずしも無視出来る大きさではない。ワイヤをx軸方向にも張ったグリッド(網目グリッド)を用いる場合には、(1.10)は上限を与えるものと考えるべきであるが、実際の角度幅はこの上限値から桁で小さいとは予想できない。

追記:民井氏の数値計算によると、z軸方向だけでなくx軸方向にも同じ間隔でワイヤを張った正 方形網目グリッドを用いた場合、角度広がりはおよそ(1.8)式の1/2の程度である。

1.4. ビーム軸の調節

磁場領域を出たビームはその後の加速電極によって約19kVに加速される。従って、 加速系の軸と、磁場領域を出た後のビームの軸が一致することが望ましく、磁場領域 の出口でビームの位置と角度の調節が望まれる。1.2.節の推定においてもそれが必要 される程度のイオン引き出し状況である。少なくとも磁場強度(電場強度)が一つの 調節要素に使用できることを考慮すると、イオン発生位置、若しくはイオン引き出し 角度のどちらか一方の微調整を考慮しておくことが望まれる。前者は Li 原子線ビー ムの位置・方向の調整やタングステン板の位置調節で達成できるし、後者は磁場領域 出口に電場のデフレクター(ステアラー)を挿入することでも達成出来る。こうした 調節要素は常時調節可能でなくとも、事前に実験的に最適化した後で固定する事でも 良いかも知れない。

2. 磁場領域の輸送行列と領域出口でのビームサイズ

2.1. 引き出されたイオンの初期条件

引き出されたイオンの輸送を考えるために、新たな座標系をとり、輸送行列を計算する。即ち、x, θ を図 1.1 の紙面内で軌道に直角な方向の座標とし、y, φ は紙面に直角方向の座標とする。x,yの原点は中心軌道上に取り、 θ , φ は中心軌道からの傾き角度(の正接)である。これ以降の議論では、ビームの初期条件、即ち酸化タングステン板から引き出されるイオンビームに対して、以下の最大値を想定する。

 $x_0 = \pm 12 \text{ mm}, \quad \theta_0 = \pm 25 \text{ mr}, \quad \delta = 0, \quad y_0 = \pm 8 \text{ mm}, \quad \varphi_0 = \pm 25 \text{ mr}$

2.2. 磁場領域出口での輸送行列とビームサイズ

 $\rho = 100 \text{ mm}$ とした場合、1.1.節に想定した磁場領域の中心から磁場出口境界までの 輸送行列はおよそ表 2.1 の通りとなる。EFB circle 近傍の磁場の変化は、field clamp が あまり効果を持たない場合のそれを想定している。

表 2.1. 磁場領域出口境界までの輸送行列(単位 m, rad)

	x	θ	δ		У	arphi
x	0.752	0.060	0.007	У	1.000	0.079
θ	-4.142	1.000	0.828	φ	-0.423	0.967

この輸送行列と上記のビーム初期条件から、磁場の出口では、

初期角度幅=0 : $x = \pm 9.4$ mm, $\theta = \pm 50$ mr, $y = \pm 8.0$ mm, $\varphi = \pm 4$ mr 初期角度幅有限: $x = \pm 10.9$ mm, $\theta = \pm 75$ mr, $y = \pm 10.0$ mm, $\varphi = \pm 28$ mr

程度となることが分かる。磁場領域を出るビームについて、その太さはx,y両方向で

大差は無いが、x 方向には相対的に強い収 束傾向、y 方向に弱い収束傾向にある。従 って、(初期角度幅を無視して)像を結ぶ 点の磁場出口境界からの距離(以下、イメ ージ位置若しくは image distance と呼ぶ) は、x, y座標について異なることになる。 これは磁場の後に続く加速領域が軸対称 である場合には、ビーム制御上必ずしも喜 ばしいことではない。このアンバランスを 取り除くには、磁場境界の出口角度を調節 する事が考えられるが、それによるイメー ジ位置の変化をプロットしたものが図 2.1



図 2.1. 磁場出口境界の角度変化による イメージ位置の変化(初期角度幅=0)

である。イメージ位置は*x*, *y*座標に関して最小で 0.8m も異なっており、磁場境界角度の調節によっては、このアンバランスの除去は不可能である。なお、民井氏による数値的な軌道追跡の結果からは、*y*方向の収束作用はもう少し大きいことが示されている。これを考慮した計算は後で考慮する。

3. 加速電極

3.1. 加速管の輸送行列

軸対称な構造を持つ加速管の輸送行列は円筒座標系で表現出来るが、粒子が加速管の軸の周りに角運動量を持たない場合の円筒座標系での輸送行列(軸からの変位 r と軸に対する勾配 r'、即ち(r, r')による表現)は、rが0でない場合には、そのまま (x, θ) 及び (y, φ)の表現に読み替えることが可能である。(実は、この読み替えを行うと、軸の周りの粒子の角運動量が有限であっても正しい取り扱いになる。)

長さ1、エネルギー利得N (= 出射エネルギー/入射エネルギー比)の加速管で、入り口、出口の焦点距離f_{入口}、f_{世口}は

$$\frac{1}{f_{\lambda \Box}} = \frac{1}{\xi} \frac{N-1}{4l}, \qquad \frac{1}{f_{\Box \Box}} = -\frac{1}{\xi'} \frac{N-1}{4Nl}$$
(4.1)

で与えられる。 (ど) は経験的な入口(出口)のレンズ効果の焦点距離補正因子で、

$$\xi(\xi') = 1 + 0.57 \frac{d}{f(\xi = 1)} \tag{4.1'}$$

である。この焦点距離を用いて、(r, r)の表現で輸送行列は次のようにを構成される。

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{f_{\boxplus \Box}} & 1 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{N}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \frac{2l}{\sqrt{N}+1} \\ -\frac{1}{f_{\lambda \Box}} & 1 \end{pmatrix}$$
(4.2)

出口レンズ 一様場加速部 入口レンズ

3.2. 1本の加速管を使用した場合の効果

何段かの加速電極(ギャップレンズ)による収束・発散効果は、各段が「等長、等 電位差」なら、一本の加速管による収束・発散効果と大きく変わるところはない。こ のため、先ず一本の加速管による加速を考えて見る。上記の式はfがdに較べて大き いことを前提としており、実際にはN = 25(入射 0.8keV、出射 20keV)にも達するよ うな大きなN値には(特に ξ に関して)適用出来ないが、当面そのことは無視する。

図 3.1 及び 3.2 は、長さ *l* = 100 mm の加速管が磁場領域から 50 mm 離れて置かれ、 その加速管から更に下流 150 mm までビームを輸送した場合の、ビームサイズ及びイ メージ位置を計算したものである。表面電離器での適切なイオン引き出し電圧を考慮 するために、加速管でのエネルギー利得を変化させている。図 3.2 でイメージ位置が 負であるのは、基準とした加速管下流 150 mm の位置から見てイメージは上流にある ことを意味し、ビームは発散しながら出射している事を示している。N が大きくなる ほどイメージ位置は上流に移動し、ビームサイズは大きくなる。N が 10 以上でそれ らの N 依存性は飽和する傾向にある。

(4.2)式の適用可能性とビームサイズから見て、一般的にはN値は小さい方が有利そ

うである。このためには、表面電離器からのイオン引き出し電圧を大きくする必要がある。ビーム最終エネルギーを19kVとし、表面電離器からの引き出し電圧の現実的な限界を1.5kV程度としてみると、N=13程度であり、その場合、ビームサイズ、イメージ位置はx, y座標に関してそれぞれ±9.2mm, ±5.6mm及び0.17m, 0.13mの程度となる。イメージ位置のx-y-アンバランスは解消する事は出来ないが、磁場領域出口に較べてその程度は小さくなっている。

初期角度幅を考慮するとビームサイズは *x-*, *y-*方向についてそれぞれ±9.8mm 及び ±5.8mm 程度に大きくなる。また加速部出口での角度幅は±58.3 mr 及び±51.0 mr とな るが、このうち初期角度の寄与は *x-*方向で約 6 mr、*y-*方向で 9.7 mr である。この様に 初期角度幅の影響が比較的小さくなっているのは、加速による収束効果のためである。



図 3.1. 加速管下流 150 mm における ビーム半幅(初期角度幅=0)

3.3. 2段階の加速

複数段のギャップレンズの効果を調 べるためには、"短い加速管"を複数使 用する場合を想定して見れば良かろう。 そのサンプルとして、仮想的に *l*=25mm の2本の加速管の中間に長さ50mmのド リフトスペースを挟んだ場合(3 電極2 ギャップ)を考え、上記と同様の計算を したものが図 3.3 及び 3.4 である。2 本 の加速管とドリフトスペースの合計長 は1本の加管の場合と同じく100mm と してあり、ビームは加速管下流150mm に 輸送した。2 本の加速管の合計エネルギ 一利得は前節の考察から14 とし、図の横



図 3.2. 加速管下流 150 mm から見た イメージ位置(初期角度幅=0)



図 3.3. 2 段加速の場合、加速管下流 150 mm におけるビーム半幅(初期角度幅=0)

軸は第1段のエネルギー利得である。 従って、図の曲線の右端は第1段の みで加速したことを意味し、左端は 第2段のみの加速に対応する。(ただ し、第1段または第2段のみの加速 の場合、図3.3,3.4の結果は、必ずし も図3.1,3.2の結果に一致するわけ ではない。加速管の長さが異なるた めである。)

ビームサイズ、イメージ位置の x-y アンバランスには、3.2 節におけるよ り著しい改善が見られる。初段の利 得が小さいほど、ビーム幅は小さく、 イメージ位置は下流に位置するよう になる。現実的な加速電圧配分を考



図 3.4. 2 段加速の場合、加速管下流 150 mm から見たイメージ位置(初期角度幅=0)

え、イメージ位置の可変性も考慮すれば、第1段利得を3.0(従って第2段利得4.67) 程度とするのが一つの目安であろう。この時、初期角度幅を考慮するとビームサイズ は*x-*,*y*-方向にそれぞれ0.1 mm及び0.4 mm程度増加し、角度はそれぞれ13 mr及び 16 mr程度増加する(いずれも半幅)。初期角度幅の影響は2段加速の場合の方がやや 大きい。

1本の加速管の場合と2段加速の場合の違いは、磁場領域を出るビームのx, y座標の振る舞いが異なるため、下流に置かれるレンズの位置と強度によってx座標、y座標の影響の受け方が異なるためである。2つの加速法を較べるとき、加速ギャップは複数にすることが望ましく、かつエネルギー利得は加速の初段で小さく後段で大きくすることが有利であると推定出来る。また、第一段利得を調節することにより、イメージ位置を変化させることが出来ることは、更に下流の静電デフレクタへの入射条件を整える上で重要な意味を持つ。

3.4. 加速部直前のドリフトスペースの効果

上に述べたように、ビームが磁場領域を出る時の x 方向、y 方向座標の振る舞いの 違いにより、加速領域のレンズ効果が異なるところから、加速領域の配置の影響を調 べておくことも必要であろう。上記2段加速で初段エネルギー利得3.0、後段利得4.67、 合計利得14.0の場合について、磁場出口と加速部の距離を変化させながら、加速部下 流150mm までビームを輸送した場合の計算結果を図3.5及び3.6に示す。加速部直前 のドリフト長のビーム幅、イメージ位置への影響は、この仮定した加速条件では大き くはない。(1本の加速管の場合、変化は相対的に大きい。)

以上から、複数加速ギャップを持つ加速装置を用い、適正な加速電圧配分を考慮す

ることが重要であると結論出来る。これまでに述べた計算からは、表面電離器でのイ オン引き出し 1.4 kV 程度、2 段加速で初段利得 3.0、後段利得 14/3 \approx 4.7 程度が一つの 推奨加速方式と言っても良い。この時、イメージ位置は加速管出口から 41±5 mm に ある。また、ビームの角度幅は(初期角度幅=±25 mr として) x 方向±47.7mr、y 方向 ±43.8mr とほぼ同じである。





- 図 3.5. 加速位置によるビーム幅変化 (2 段加速,*N*₁=3,初期角度幅=0)
- 図 3.6. 加速位置によるイメージ位置変化 (2 段加速, N₁=3, 初期角度幅=0)

4. ECR 入射部での粒子軌道

加速部を鉛直上方に出たイオンはさらに静電デフレクタで 90° 偏向され、水平に ECR イオン源(以下、ECR と略記)に入射される。イオンは 19 keV のままで ECR の軸上を進行し、磁場の最大位置から少し ECR 中心に寄ったところで減速され、プ ラズマに入射する。入射効率を上げるためには、このプラズマ入り口でイオンビーム の太さが最小であることが望まれ、その実現が静電デフレクタを含むイオン輸送系へ の要請となる。デフレクタについて考察する前に、ECR 入射部でのイオンの運動を調 べておく。

4.1. ECR 入射部における軌道方程式

ECR イオン源の磁場は軸対称コイル磁場と考えて良い。軸方向(ビーム進行方向) を *z*-軸とする円筒座標系(r, φ, z)を考え、*z* に関する微分をダッシュ ' で表すこととす ると、任意の粒子の軌道座標は、r, r' の1次の近似(近軸光線近似)で次のように書 くことが出来る。

$$r'' - r\varphi'^2 = \frac{eB}{m\nu}r\varphi' \tag{4.1}$$

$$2r'\varphi' + r\varphi'' = -\frac{e}{m\nu} \left(\frac{1}{2}rB' + r'B\right)$$
(4.2)

但し、軸上の磁場 B_z を単にBと表し、Bはzのみの関数であるとした。また、以下では強度Bの一様磁場内で粒子の描く円軌道の半径を ρ とする(ただし、Bと同じ符号を持つ)。(4.2)式は容易に積分する事が出来、

$$r^{2}\varphi' = -\frac{e}{2mv}r^{2}B + C = -\frac{r^{2}}{2\rho} + C$$
(4.3)

となる。z-方向の速度成分が一定なら(4.3)式は粒子の軸の周りの角運動量と等価であるため、以下では、 $r^2 \varphi'$ を引用符付きで"角運動量"と呼ぶことにする。Cは"角運動量"の初期値である。これを用いて(4.1)式は

$$r'' = -\frac{1}{4} \left(\frac{eB}{mv}\right)^2 r + \frac{C^2}{r^3} = -\frac{1}{4} \frac{r}{\rho^2} + \frac{C^2}{r^3}$$
(4.4)

となる。(4.4)式の右辺第 2 項は、r が 0 に近い時のみ大きな寄与を持ち、r を負にさせない働きをする。粒子軌道が z 軸と交叉しない(r=0 にならない)状況を取り扱う場合には、磁場領域の外で $\varphi'=0$ なら、C=0 としても構わない。その場合、微分方程式は

$$\varphi' = -\frac{e}{2mv}B = -\frac{1}{2\rho} \qquad (\rightarrow \quad \varphi = \varphi_0 - \frac{e}{2mv}\int_0^z Bdz \quad) \qquad (4.5)$$

$$r'' = -\frac{1}{4} \left(\frac{eB}{mv}\right)^2 r = -\frac{1}{4} \frac{r}{\rho^2}$$
(4.6)

となり、(4.6)式の形から、磁場はビームに対して「軸に沿って強さ(収束力)が変化 する凸レンズ」の効果を持つことが分かる。

粒子軌道が z 軸と交叉する可能性のある場合には(4.4)式を用いなければならない。 (4.4)式の右辺第 2 項は r と共に急速に減衰するが、C が如何に小さくても r = 0 の近 傍では極めて大きな効果を持つ。このため、C = 0 に対応する解は $C \rightarrow 0$ の極限とし て得られる。この極限では、この項は r = 0 で r'の符号を反転させる効果を持ち、結 果的に(4.4)式の解は(4.6)式の解の負の部分を正に折り返したものとなる。

なお、*z*-軸に直角面内に*x*-, *y*-軸を持つ直角座標系での表現を用いると、*r*, *r*'及び"角運動量" $r^2 \varphi'$ は次のように表される。

$$r = \sqrt{x^{2} + y^{2}},$$

$$r' = \frac{xx' + yy'}{\sqrt{x^{2} + y^{2}}},$$

$$r^{2}\varphi' = xy' - x'y$$
(4.7)

4.2. 定性的考察

ここで、少々乱暴であるがBの分布をzに関して長さlの矩形の分布で近似してみよう。簡単のためにC=0の場合 ($C \rightarrow 0$ の極限)を考える。上記の議論から、磁場内での動径座標はzに関して周期 $4\pi p$ (一定)の関数として

$$r = \left| 2r_0' \rho \sin \frac{z}{2\rho} + r_0 \cos \frac{z}{2\rho} \right|$$
(4.7)

と表すことが出来る。周期関数となるのは運動が螺旋運動であることの帰結である。 rの最大値は

$$r_{\rm max} = \sqrt{\left(2r_0'\rho\right)^2 + r_0^2} \tag{4.8}$$

で与えられる。ror'は、磁場に入射時の動径座標とそのz-微分係数である。

磁場の分布幅を(入り口からプラズマへの入射点まで)l = 200 mm,磁場をB = 3 Tとしてみると、 $\rho = 16 \text{ mm}$ となり、動径座標の振動周期は約 $204 \text{ mm} \approx l$ となる。即ち、粒子は磁場に入射後、ほぼ 1 周期を経過してプラズマ領域に到達する。磁場入射時に $r_0 \approx 0 \text{ mm}$, $r_0' \approx 20 \text{ mr}$ 程度であれば、 $r_{\text{max}} \approx 0.7 \text{ mm}$ 程度となる。 r_0 が数mmである場合には、振幅はもっぱら r_0 で決まるであろう。

(4.8)式において、根号の中の第1項は磁場に依存し、第2項は磁場に依存しない。 従って、「磁場入射点」でr=0、つまり「磁場入射点」でビームを収束させることが 望まれる。但し、一般に「磁場入射点」を定義することは困難である。磁場をその最 大強度の地点まで(軸に沿って)積分し、積分値が等しい矩形の磁場分布で置き換え た場合、矩形分布の上流端が「磁場入射点」 の一つの目安であろう。

4.3. 静電デフレクタ出射後のビーム収束点

上に述べたように、ECR 磁場にビームを どのように入射させるかによって、プラズ マ領域入り口でのビームの太さが決まる。 そこで、現実に近い磁場分布に対して(4.4) 式を数値的に解いて見ることとする。

軸上の軸方向磁場(B_z)分布にはKTサイ エンス川口氏の(TOSCAによる)計算があ る。計算結果をグラフから読み取り、およ そそれを再現するgauss分布を考える。図4.1

はそのようにして 得たgauss分布(実 線)と計算磁場(点、 グラフ読み取り値) との比較である。 gauss分布はおよそ 計算磁場分布を再 現しているとして 良かろう。

このgauss型磁場 分布を用い、 $C \rightarrow 0$ の極限での(4.4) 式の解をRunge-Kutta-Gill 法で数値 的に求めた結果を \boxtimes 4.2 (B_{max} = 3.0 T) 及び図 4.3 (B_{max}= 2.0 T) に示す。相対的 なBz分布はピンク色 の曲線で示されて おり、横軸の0点は ECR磁気シールド 外面(図中縦線)に 設定されている。粒 子軌道の初期条件は、











は、 図 4.3. 最大磁場 2.0 T での入射粒子軌道の r 座標(初期角運動量=0)

z = -300 mmにおいてr = 10 mmとし、入射角度(収束角度)をパラメーターとした結果が表示されている。

 B_{max} = 3.0 Tの図 4.2 からは、前節に推論したように粒子は入射からほぼ 1 周期の螺 旋運動を経てプラズマ領域の入口(最大磁場の場所)に達する様子が見られ、軌道の r座標は入射角 0 mrの場合に磁場内で初期値の半分程度となる。より収束する方向に 角度を持って入射する場合には、磁場内のr座標を最小にする入射角度が存在するの が分かる。 B_{max} =2.0 Tの場合は、振動周期が長くなり、r座標の振幅がやや大きくなる が、定性的傾向は変わらない。

磁場内でのビームの太さの目安と して、粒子が磁場内に入射後の最初の r座標の極大値を取ることとする。図 4.4 はこの極大値の入射角度依存性を 示したものである。図から明らかなよ うに、 B_{max} = 3.0 Tでは入射角 20 mr強、 即ちz = 10/0.02 – 300 = 200 mmより若 干上流に収束するようにビームを入 射させれば、ECR磁場内でのビームサ イズの最小化を図れることになる。 B_{max} = 2.0 Tの場合と比較すると、 B_{max} が小さくなるにつれ、ビームはより下 流に収束するように入射させること が望ましいと推定されるが、この程度



図 4.4. 磁場内での軌道 r 座標の第1 極 大値と入射角度との相関

の磁場強度の違いでは、あまり問題にする必要はなさそうである。

なお、前節に述べたような矩形磁場分布の近似では、r変位を最小化する入射角度は -18 mr となり、矩形磁場分布による推定もさほど悪くないことを付記して置く。

4.4. 初期"角運動量"の効果

粒子を2重収束するように ECR に入射させることは、ECR 軸の周りの"角運動量" 初期値を0にしようとする試みとも言える。その意味では、Li ビーム輸送において"角 運動量"初期値の重要性は薄いとも言えるが、実際には、表面電離器の出口でビーム は1.3 節に述べたように有限の角度幅を持つ。このため Li 粒子の ECR 入射条件は2 重収束条件の周りに広がりを持つことになり、結果的に C=0 の周りに有限の幅の"角 運動量"を持つことになる。

"角運動量"初期値Cの効果を調べたものが図 4.5 ($B_{max} = 3 \text{ T}$)及び 4.6 ($B_{max} = 2 \text{ T}$)である。いずれもC=0の場合にz=200 mmで軸と交叉するよう r_0 'が設定(=-20 mr)されている。

これらの図から分かるように、大きな"角運動量"初期値はECR磁場内でのrの振幅を大きくさせる効果を持つ。これは、粒子が磁場の軸とr-ベクトルに垂直な速度成

分を持つために、磁場領域に入射するまでにこの速度成分による軸からの変位が大き くなるためである。C = 0の場合の収束位置を前提にすると、この変位はほぼ $(C/r_0) \cdot (r_0/r'_0) = C/r'_0$ の程度であり、これが定性的には、(4.3)式の r_0 を与えると考えれ ば理解できるところであろう。

図からも知れるように、C = 0.05 mm即ち $C/r'_0 = 2.5 \text{ mm}$ 以下ではrに著しい増加は見られない。rを出来るだけ小さく押さえようとする場合、 r'_0 にもよるが今の場合、 $C/r'_0 \leq 4 \text{ mm}$ 程度までは許容しても良いと思われる。言い換えれば、ECRの「磁場入射点」に2重収束点を想定する場合、結像点でその像幅は上下、左右とも±4 mm程度に押さえておきたいと言うことになり、その場合、ECR磁場内ではおよそその半分程度ビームサイズになるであろう。



図 4.5. 最大磁場 3 T で、異なる初期"角運動量" L を持つ粒子の R 座標。r'の初期値は-20 mr



R-coordinate for Bmax=2T, RI=10mm, RPI=-20mr with different angular momentum

図 4.6. 最大磁場 2 T で、異なる初期 "角運動量" L を持つ粒子の R 座標。r'の初期値は-20 mr

5. Spherical condenser (SC)型静電デフレクタ

既に述べたように、鉛直上方に向かって引き出されたLiイオンビームを水平な ECR の軸に乗せるためには、偏向角度 90°の静電デフレクタが必要である。このために Spherical condenser (以下、SC と略記)を考えて見る。SC の光学的特徴は、x, y 両方 向に対称な収束作用を持つことであり、補足的収束要素の節約に有効である。SC の fringing field の影響はx, y 両方向に対称ではないが、本章では適当な fringing field 補 正を考慮するものの、その非対称性は当面無視する。

偏向角度 90°の SC は、物点一入口間距離(以下、入口距離と呼ぶ)、出口一像点 間距離(以下、出口距離と呼ぶ)がともに平均軌道半径と同じ場合、物点一像点に関 して対称な2重収束系となる。この様な系を以下では対称 SC 系と呼ぶ。SC を出たイ オンを ECR に入射させることを考え、本章では出口距離を仮に 500 mm 程度と設定し て光学的検討を行う。

5.1. 対称 SC 系による ECR イオン源への入射

対称 SC 系を採用するならば、出口距離、入口距離、平均軌道半径 ρ を全て 500mm 程度にする必要がある。3.2 節の議論から予想される加速管を出た後のイメージ位置 を考慮すると、加速管出口—SC 入口間距離は 540mm 程度が望ましいことになる。

これを前提として、最終点(SC 収束点)までビームを輸送した時の輸送行列は以下の通りとなる。ただし SC 入口距離は最終イメージサイズを最小化するように微調節を加えた。(入口距離 560mm)。

表 5.1. 対称 SC (入口距離 ≈ 出口距離) による収束点での輸送行列

	x	θ		У	φ
x	-0.0608	-0.0724	У	0.0750	-0.0402
θ	3.918	0.2695	φ	5.624	0.5463

これから最終ビームスポット幅、角度幅を推定してみるとx(水平),y(鉛直)方向 について、初期角度幅の無い場合それぞれ ±0.7 mm,±47 mr 及び ±0.6 mm,±45 mr、初 期角度幅のある場合それぞれ±2.5 mm,±54 mr 及び±1.6 mm,±59 mr の程度となる。ビ ームスポット幅への主たる寄与はビームの初期角度幅によるものであり、角度幅への 主たる寄与は初期位置の幅によるものである。電極内でのビーム最大幅は±35mm 程 度と推定され、SC の電極間ギャップは 70mm 程度が必要である。

5.2. 非対称 SC 系による ECR イオン源への入射

上に見たように、対称 SC 系を用いれば、最終点(ECR 内「磁場入射点」)でビー ム幅はまずまず小さい値が得られる。しかし、ビーム角度幅が大きいため、ECR への 導入部分で空間的な広がりが大きく、他の部品との干渉の可能性が出てくる。また、 SC 軌道半径が大きいことから装置が大型化することも難点である。このような問題 を解消するためには、SCの使用を入出口に関して非対称にし、装置を小型化しなが ら出口距離を必要なだけ確保することが考えられる。

このため、 $\rho = 250 \text{ mm}$ に縮小し、入口距離を変化させて、SC下流部で最外周ビーム軌道を計算したものを図 5.1 に示す。当面、ビームの初期角度幅は無視する。図で黒線はx(水平)座標、赤線はy(鉛直)座標、横軸はSC出口からの距離である。複数の線はSCの入口距離をパラメーターとし、

入口距離 = 40 mm + $K \cdot \rho$

として、K = 1.25 - 0.25の範囲で $K \ge 0.25$ おきに変化させた結果である。当然であるが、Kが小さくなると最終点でのビーム幅は増加する。

ρを小さくしたために、SC 出口でのビーム幅は上記対称 SC 系の場合のほぼ 1/2 に 減少し、装置の小型化に

減少し、装直の小空化に 有利な結果となっている。 最終点で最小ビームサイ ズを実現するには $K \approx 0.6$ 程度とする必要があり、 その時、ビームサイズは (初期角度幅の寄与を無 視して) ±1 mm 程度とな る。またその時、ECR イ オン源ヨーク入口付近の ビームサイズは±5 mm 程 度となるであろう。

以上から、非対称 SC 系



図 5.1. SC 下流における最外周粒子軌道座標。黒:x,赤:y (ρ=250 mm,初期角度幅=0)

の使用においても、さほどビーム形状の悪化を招くことなく、ビームサイズの最適化 が出来そうである。

6. SC による現実的な輸送系

上に掲げた計算では、傾向を知るために多少の不正確さを許容した。以下では、ρ= 250 mm の SC を用い、排除出来る不正確さは排除して実現性の高いビーム輸送につい て考察して見る。

6.1. SC 出口距離と入口距離の可変性

4.3 節の考察から、ECR の「磁場入射点」でビームサイズを最小化する事が望まし い。具体的装置設計に対応するために、SC を出たビームは(ECR 磁場が存在しない 場合に)出口距離 450 – 700 mm の範囲で収束出来るよう考慮することにする。出口 距離を可変にするには、SC の入口距離を可変にしておく必要がある。 $\rho = 250$ mm の SC にいわゆる barber's rule を適用してみると、必要な入口距離の変化幅は約 50 mm であると算出できる。この入口距離の調節は、加速後のイメージ位置の調節によって 行うのが適当であるが、3.3 節に述べたところから、2 段加速部の初段エネルギー利得 (中間ドリフトスペースの電圧)をおよそ3 ± 1.5 の範囲で変化させることより、こ れは達成可能であることが推測される。

6.2. SC 後のビーム形状

具体的にSC後の(ECR磁場の影響を考えない時の)ビーム幅を計算した結果を図

6.1 に示す。ただし、ビ ームの初期角度幅は無 視している。図はSC出 口距離 450, 575, 700 mmでビーム幅がx, y方 向でほぼ等しくなるよ うに、2段加速部の初 段エネルギー利得N₁を 調節している。ただし、
図 3.4 に見るように、
N₁が大きい場合にはN₁ の変化に対する加速部 後のイメージ位置の変 化率が小さくなること





を考慮して、(N_1 =3.0 ではなく) N_1 =2.5 で出口距離がほぼ 575 mm(中心値)程度となるように、加速部出口-SC入口間距離を 154 mmと設定している。

図 6.1 に見るように(初期角度幅の寄与は無視して)ビームの完全な2重収束はN₁の 調整のみでは不可能であり、最終点でのビーム幅は出口距離 450-700mmに対して ±3.5-±5mmである。少々大きい最終ビーム幅であり、初期角度幅を考慮すると更に ビーム幅が広がることを考慮すると、何らかの補正を行うことが望まれる。

6.3. 静電 Q レンズによる SC 後のビーム形状の改善

SC後のビーム収束形状を改善するには、SC後に収束要素を置いて2重収束を実現 するのが一つの方法である。このためには、収束効果がx,y方向について非対称な収 束要素を用いる必要があり、その代表的要素は静電Qレンズである。上記の3ケース について、SC下流 100 mmに長さ 50mmのQ電場を設置し、ビーム幅の最小化を試み た結果を図 6.2 に示す。N₁は図 6.1 の場合と同じ値である。図 6.1 と較べて、大幅に最 終ビーム幅の

減少が見られ、 SCの出口距離 450 - 700 mmに 対して(初期角 度幅 = 0 の場 合) $\pm 0.4 - \pm 1.5 \text{mm}$ である。 N_1 も含めて微 調すれば、さら に小さいビー ム幅も不可能で はないが、ここで は省略する。

全系にわたる粒 子軌道のプロット (初期角度 = 0)を 図 6.3 に示す。また、 静電 Q レンズを出 た後のビーム角度 幅と,粒子 electric rigidity = 38 kV の場 合の Q レンズの強 度を表 6.1 にまとめ ておく。 outermost trajectory, corrected by Q behind SC



図 6.2. SC 下流で Q レンズによるビーム補正結果。黒:x,赤:y (ρ=250 mm,初期角度幅=0)

coordinates of outermost trajectory for N1=4.75, spherical condencer, LO=0.45 R ACC SC Ŋ F 14 12 10 displacement (mm) -16 -18 -20 -22 -24 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

図6.3 SC下流でQレンズによるビーム補正後の最外周軌道座標 黒:x,赤:y (ρ = 250 mm, 初期角度幅=0)

distance along central trajectory (m)

表 6.1. SC 下流 Q レンズで補正後のビーム角度(ビームの初期角度幅の寄与を含まず。)

出口距離	450 mm	575 mm	700 mm
x 方向ビーム角度幅(mr)	±24.4	±16.7	±14.1
y方向ビーム角度幅(mr)	±30.2	±23.8	±20.8
静電Q電場勾配(V/cm²)	94.0	84.2	71.7

6.4. SC 上流部でのビーム補正

前節と同様のビーム形状の改善は加速部出ロ-SC 入口の領域でビーム調整をする ことでも達成出来るはずである。その場合には、加速部直下流で*x*,*y*方向の収束位置 の違いを無くすか、SC に対する物点位置の違いを無くすことになる。3.2 節に見るよ うに、2 段加速のエネルギー利得の配分により加速部下流の収束位置を変更すること は可能であるが、変化幅は十分な大きさを持たないから、可能な補正は後者であろう。 その場合には、SC 直前に Q レンズを置き、加速部下流収束点の虚像を*x*,*y*方向で一 致させて SC の物点とすることとなる。SC の直前に Q-doublet を導入することが、 flexibility において適当であろう。ここでは、詳細は省略する。

7. Cylindrical condenser (CC)型静電デフレクタ

上記の考慮から、SC は利用できる静電偏向器であると結論できるが、その難点は 球面状電極の製作の困難さにある。その意味では、cylindrical condenser(以下、CC と 略記)についても検討しておくことは重要である。CC は製作の容易さにおいて優れ るが、*x*-,*y*-両方向に収束作用は持たないと言う難点を持つ。従って、補助レンズとの 組み合わせで目的を達成することを考慮しなければならない。DQ+CC 若しくは CC +DQ がその候補である。

7.1. DQ + CC

DQ + CC の可能性を調べた結果を図 7.1 に示す。計算において想定した加速部以降の geometry、条件は表 7.1 にまとめる。

表 7.1. 検討した DQ + CC 系の geometry

第1段加速部利得N ₁	2.44	加速部出口-QU距離	150 mm
上流 Q(QU),下流 Q(QD) 長さ	50 mm	QU-QD 距離	30 mm
CC 平均半径	250 mm	QD-CC 入口距離	40 mm

outermost trajectory in the dcownstream of CC coupled with Q doublet





(*ρ* = 250 mm, 初期角度幅=0)

この検討では、CC出口距離に関わらず、加速部第1段利得N₁は固定されている。 その様な条件で収束制御が可能である点がQD導入の利点である。しかしこの系では x,y座標に大きなアンバランスがあるのが明らかである。特にy方向については、収束 位置に入射する角度が浅く、このため、ビームの初期角度幅が最終ビーム幅に大きな 寄与を持つことが考えられる。4章の言葉で言えば、"角運動量"が大きくなると言う ことである。この y座標の問題は、DQ上流での軌道を調整することによって変化さ せることができる。そのための調節要素には、磁場直後のドリフト長、加速電圧配分、 加速部直後のドリフト長等が考えられる。

実際、磁場直後のドリフト長を 200 mm に大きくした結果 (CC 出口距離=450 mm) では、CC 出口で最外周軌道座標 (初期角度幅を無視) は *x*, *y* 共ほぼ 4 mm と等しくす ることができる。ただし、*x*, *y* 両方向とも最終収束点への入射角度が浅く、ビームの 初期角度幅の寄与が大きいこと、及び CC 上流の寸法が大きいことが、その場合の欠 点である。

7.2. 系のコンパクト化と TQ + CC によるビーム形状の制御

上述のように加速部周りの geometry によってビームの最終形状を制御することは 制約も大きい。より制御の自由度を増すためには DQ を Q-triplet (TQ) することが考 えられる。その場合、その出発点としての機器配置(geometry) は optics を度外視し てコンパクトに決めることも可能である。

(a) compact arrangement (DQ + CC)

先ず比較のための系として、DQ+CC 系で機器の配置をできるだけコンパクトになるよう、表 7.2 のように定めて見る。

表 7.2. "compact arrangement"の geometry

磁場出口-加速部入口	50 mm	加速部全長	$100 \text{ mm} (N_1=3.0)$
加速部出口-DQ 入口	100 mm	DQ 全長	130 mm (単一Q長50 mm)
DQ 出口-CC 入口	40 mm	CC 半径	150 mm

電離器中心から ECR イオン源中心までの高さの差は 640mm である。

この geometry での粒子軌道を図 7.2 に示す。ただし、図では最上流磁場領域に当初 想定した磁場以外に、民井数値計算(field clamp 無し)を光学的に再現する磁場も考 慮している。両想定磁場の特性の違いは表 7.3 の通りである。大きな違いは y-収束効 果にあるが、その違いは図に見るとおり軌道に大きく反映する事はない。加速部の収 束効果が下流に支配的影響を持つためである。



図7.2. "compact arrangement"(DQ + CC系)での最外周粒子軌道。黒:*x*,赤:*y* (初期角度幅=0)

表 7.3 当初想定磁場と民井数値計算磁場の比較

	x-収束位置	y-収束位	置
当初想定磁場:	260 mm	2440 mm	(電離器中心から軌道に沿った長さ)
民井数値計算:	218 mm	418 mm	(同上)

民井想定磁場の場合で、収束点でのビーム座標の初期角度 θ, φ 依存性は

 $(x \mid \theta) = -0.112 \text{ mm/mr}, \quad (y \mid \varphi) = 0.619 \text{ mm/mr}$

となる。*φ* = ±25 mr とすれば、*y* = ±15.5 mm となり、*y*-方向ビーム幅は著しく大きい。 (b) DQ→TQ の変更(TQ + CC)

上記の系の DQ の部分のみを(同一形状の singlet Q を追加して)TQ に変更した場合には、CC 下流にビームを収束させるだけでなく、ビーム形状を制御する新しい自由度を得ることが出来る。この変更で、電離器中心から ECR イオン源中心までの高さの差は 720mm に増大する。民井数値計算に対応する磁場を想定し、CC 下流 450mm を収束点とし、その上で、CC 出口でビームの *x*-, *y*-幅を等しくするように TQ を調節した場合の結果を図 7.5 に示す。CC 下流でのビーム形状の *x*-, *y*-アンバランスは解消しているのが明らかであろう。

収束点における輸送行列の値を表 7.4 にまとめた。 $(x | \theta)$, $(y | \varphi)$ の値から、表面 電離器から引き出されるビームの角度幅が ±25 mr程度であれば、最終ビーム幅(半 幅)はx: ±7.4 mm, y: ±5.0 mmとなることになり、少々不満の残るビーム幅を得る。"角 運動量"最大値はC = 0.25mm程度であり、 $C/r'_0 = 8.5$ mmに達する。この時、19 keVの 1 価のイオンに対してQの電場強度は表 7.5 の通りである。



coordinates of outermost trajectory, compact arrangement, TAMII mag., N1=3, TQ+CC, LO=0.45m

図 7.5. "compact arrangement"の DQ を TQ で置き換えた場合の粒子最外周軌道。黒:*x*,赤:*y* (初期角度幅=0)

表 7.4. TQ + CC "compact arrangement"の輸送行列(単位 m, rad)

	x	heta		У	arphi
x	0.0	-0.297	У	0.0	0.198
θ	0.896	-0.200	arphi	-1.344	0.494

表 7.5. TQ + CC 系における静電 Q レンズ強度(電極長 = 50 mm)

Q電極	Q-strength	field gradient	electrode voltage
(<i>L</i> =50 mm)	(m^{-2})	(V/cm^2)	(Volt, <i>R</i> =10mm)
QU	261.2	996.5	496.3
QM	-396.2	-1505.5	752.8
QD	187.5	712.6	356.3

7.4. CC + DQ の利用 - ビーム幅の初期角度依存性とその低減

以上に見て来たたように、TQ + CC 系を用いた"compact arrangement"では、最終ビ ーム幅の初期角度幅依存性が大きい。この初期角度への依存性は、最終収束点への入 射角度を大きくすることによってのみ低減することが可能であり、上に見てきたよう に CC 上流でビームを制御することでは十分な効果が得られない。

そこで、デフレクタ系の出口(レンズを含む)でビームの広がりを大きくして最終 収束点への入射角度を大きくすることを考える。このためには、CC上流では単にビ ームは発散させることとし、CC下流で DQ レンズによる収束制御を行う。ただし、 CC下流で空間的な余裕が無くなることを考慮し、CC 以降でなく、「Q レンズ以降」 の出口距離を前節までの検討におけると同程度とすることとする。

(a) 加速部出口-CC入口距離

図 7.6 は上記の考慮に基づいて構成した CC + DQ 系で、加速部以降の最外周軌道を プロットしたものであ

る(初期角度幅 = 0)。 図には加速部出ローCC 入口間の距離(以下、 CC 入射距離)が 100, 150, 200 mm の 3 種の geometry についての計 算結果が示されており、 縦線位置がそれぞれの 場合の CC 入口位置を 示している。DQ から最 終収束点までの距離 (出口距離)は全ての 場合について 450 mm であり、CC-DQ 間距離、 Qの長さ、Qの間隔は それぞれ 40、50 及び 30 mm である。CC 入射 距離の異なるこれら3



図 7.6. CC + DQ 系における加速部以降の最外周軌道(初期角度幅 =0)の CC 入射距離(LI)依存性。縦線は選んだ3種の LI 値に対応し た CC 入り口位置を示す。出口距離は450 mm に固定されている。 黒:x,赤:y つの場合について、収束点での初期角度依存性を表 7.6 にまとめる。

表 7.6. CC + DQ 系における収束点での初期角度依存性

CC 入射距離	$(x \mid \theta)$	$(y \mid \varphi)$
100 mm	0.229 mm/mr	0.150 mm/mr
150	0.193	0.085
200	0.171	0.059

表 7.4 と較べた場合、(*x* | θ)はおよそ 1/2 - 2/3 に減少しているのが分かり、さらに減 少させるには CC 入口距離を大きく取れば良いことが分かる。ただし、CC 入射距離 を大きく取ることは CC 出口でのビーム幅の増大させることを意味し、現実的なビー ムサイズへの配慮を含んで最終的な選択を行うべきであろう。その意味では、更に大 幅な初期角度依存性の低減は困難であると言っても良い。

(b) CC + DQ 系の若干の最適化

CC入射距離を小さくすると 収束点で($x \mid \theta$) は増大する傾向にあるが、CC出ロー DQ入口間の距離を長く取ることでその増大を打ち消すことが可能である。更に、前 節でのQレンズ電場勾配は最大 1.05 kV/cm² (CC入射距離=100 mmの場合の下流Q) と かなり大きい。CC入口距離を小さく押さえ、Qの印可電圧を低減するために、Qの位 置、長さを若干調整した。その結果、Qの電場勾配は 1/3 程度に低下させることがで きたが、収束点で($x \mid \theta$)は表 7.4 の 70%程度に下げるにとどまった。

表面電離部からの収束点までの geometry を改めて表 7.7 に掲げる。表面電離器中心 と ECR 中心の高低差は約 471 mm となる。

表 7.7. CC + DQ を採用した場合の輸送系の geometry

磁場内軌道半径	100 mm	CC 内軌道半径	150 mm
偏向角度	45 °	偏向角度	90 °
磁場-加速部入口	50 mm	CC 出口-DQ 入口	100 mm
加速部全長	100 mm(N ₁ =3.0)	DQ全長	250 mm
加速部出口-CC入口	100 mm	単一Q長さ	100 mm
		O間隔	50 mm

Qレンズの電場勾配は、38 kVのelectric rigidityに対して、上流側 260.9 V/cm²、下流 側 294.8 V/cm²である。DQ出ロー収束点間の距離(出口距離、計算では 450 mmとした。) は可変であることは自明である。実際には出口距離は 450 mmより大きいことが予想 され、これらQ電場勾配値はほぼ上限を与えるものと考えて良い。

輸送行列の値は表 7.8 にまとめた。結果的には最終ビーム幅の初期角度依存性に大きな改善は見られないが、CC上流部寸法が短いのがこの系の特長である。表 7.8 の行列要素と 2.1 節に述べた初期条件を考慮すると、最外周軌道の変位は収束点でx-方向±5.4 mm、y-方向±1.4 mm 程度となる。4章の言葉で言えば、 $C/r'_0 \leq 5.6$ mmの程度である。全系にわたる最外周軌道のプロットは図 7.7 に示す。

表 7.8. CC + DQ 系を用いた輸送系の収束点における輸送行列(単位 m, rad)

	x	heta		У	φ
x	0.0	-0.216	У	0.0	0.056
θ	1.238	-0.270	arphi	-4.734	0.405

outermost trajectory for the system with CC+DQ deflector, TAMII magnet, 2-step acc. With N1=3.0, LO=0.45m



図 7.7. CC + DQ系を最適化した後で、全系に渡る最外周軌道(x₀=12 mm, y₀=8mm) 実線は初期角度 = 0、点線は初期角度幅=±25 mr とした場合に対応する。縦線は各光 学要素の出入口の位置を示す。黒:x,赤:y

8. 具体的な機器配置に対応するための optics design 指針

上に述べたところから、表面電離器で $x = \pm 12 \text{ mm}, y = \pm 8 \text{ mm}$ 程度の範囲にある Li ビームを、効率よく ECR イオン源に入射させるには、CC + DQ によるビーム輸送系 は、その flexibility において有力な候補であると言える。

最終的な Li イオン輸送系を決定するためには、更に必要な付帯機器の設置から来る空間的な制約に配慮する必要がある。ここでは、そのための光学的配慮の仕方と、 現実的な2つの例について述べておく。

8.1. geometry とビームサイズ

DQ から磁気シールド外面間での距離は、その後の検討により、500 mm は必要であることが判明して来ている。また、4.3 節におけると同様の推定から、ECR 内の仮想 収束点(ECR 磁場のない場合の収束点)は磁気シールド内 210 mm に位置させればよい。従って、DQ から仮想的収束点までの距離(出口距離)は 710 mm とすることが 必要である。

一方、加速部-CC 間には、ファラデーカップやスリット、チョッパー用偏向電極 等の設置が想定され、CC-DQ 間にはスリットの挿入も必要となることが考えられる。 こうした条件を考慮した上で、ビームサイズを"適当に小さく押さえながら"ビーム を輸送することがコンパクトな系を実現する上で大切である。

ビームサイズは、図 7.7 に見るように、*x*-座標(*x*_{max})についてはQ1 入口で最大であり、*y*-座標(*y*_{max})についてはQ2 出口で最大である。そのサイズは"極めて大雑把に"以下のように系のパラメーターに依存する。パラメーターを以下のように名付ける。

- L_I; 加速部-CC入口間距離
- $L_{\rm C}$; CC内中心軌道長
- L_0 ; CC出口-DQ入口間距離
- 1. x_{\max} は $L_{I} + L_{C} + L_{Q}$ におよそ比例する。(実効的な物点が加速部出口付近にあり、 CC が x 方向に収束能力を持たないためである。)
- 2. y_{max} は L_{C} , L_{Q} が一定ならおよそ L_{I} に比例する。(CC入口でのy-変位にCC出口出 射角度がほぼ比例するためである。)
- *y*_{max}は*L*_C(即ちρ)におよそ逆比例する。(CC出射角度(y-方向)はρにほぼ逆比例 するためである。)

こうした傾向から、ビームサイズの制御には、加速部-CC 間距離の決定が最も重要である。以下に現実的な2つの例を示しておく。

8.2. 現実的な2つの例

(a)加速部-CC間距離LIを大きく取った場合

加速部-CC間にはFaraday cupや偏向電極等の設置が予定されているため、 $L_{\rm I} = 200$ mm程度を確保したいとする要望がある。図 7.7 で単に $L_{\rm I} = 200$ mmにすると、上記 1,2 項の効果により、最外周軌道について $x_{\rm max} = 8$ mm, $y_{\rm max} = 34$ mm (いずれも初期角度 幅の寄与を無視)となる。特に $y_{\rm max}$ について増大が著しい。そこで、 $L_{\rm C}$ (ρ)及び $L_{\rm Q}$ を 調節して妥協を図ったものが図 8.1 である ($\rho = 175$ mm, $L_{\rm Q} = 50$ mm)。図 8.1 を図 7.7 と比較すると、 $y_{\rm max}$ は相対的にかなり大きい。これが $L_{\rm I} = 200$ mm と大きく取った効果であり、他の寸法の調節で補正し切れなかったことを示している。QD出口での輸送行列及びQレンズ強度は表 8.1 に示しておく。

表 8.1. LI = 200 mm の CC(ρ = 175 mm) + DQ 系による QD 出口での輸送行列と Q-レンズ強度(Q 電極長 = 100 mm)

	x	heta		У	φ	Q 強度($E\rho$ = 38 kV)
x	-0.750	-0.111	У	2.917	-0.024	QU: 233.5 V/cm ²
θ	1.057	-0.200	arphi	-4.108	0.125	QD: -262.6 V/cm ²

outermost trajectory for the geometry of prolonged exit arm LO LI=0.2m, rho=0.175m.LQ=0.05m,LO=0.71m



distance along central trajectory (m)

図 8.2 はQD出口からECR入射部にわたる領域で 4.3 節図 4.1 の軸方向成分磁場を想定し、円筒座標で最外周軌道 ($x_0 = 12$ mm, $y_0 = 8$ mm)の軸からのずれを計算したものである。初期角度幅を考慮すると、最外周軌道にも角度幅、"角運動量"幅が生じるため、その典型例について示した。図 8.2 の計算で、軸からのずれr,軸との角度(の

図 8.1. $L_{\rm I}$ = 200 mmを確保し、 ρ = 175 mm, $L_{\rm Q}$ = 50 mmとしてビームサイズの低減を図った 場合の最外周 (x_0 =12 mm, y_0 =8mm) 軌道座標。実線は初期角度 = 0、点線は初期角度幅=±25 mr とした場合に対応する。縦線は各光学要素の出入口の位置を示す。黒:x,赤:y

正接) r'、"角運動量" $r^2 \varphi'$ の初期値Cは、(4.7)式に基づき、QD出口で算出した。 "角運動量"はやや大きく、 $C/r'_0 \leq 6.7$ mmになり、結果的にビーム幅の増大が見られ るが、これは出口距離を 710 mmと大きくした代償であるとも言え、想定した条件下 では許容しなければならないところであろう。



図 8.2. 図 8.1 の場合でQD以降の軌道の軸からのずれ(左: B_{max} = 2T,右: B_{max} = 3T)。曲線 の色は、最外周軌道 (x_0 = 12mm, y_0 = 8mm) について初期角度= 0mrの場合 (黒)、 θ_0 = ±25mr, φ_0 = ±25mrを考慮して軸に対して最大角度(赤)、最小角度(ピンク)を持つ場合及び、軸の周りに最大"角 運動量"を持つ場合(緑)に対応する。縦線は直上の項目の位置を示す。

(b)加速部-CC間距離LIを節約した場合

上に見たように、加速部-CC間距離を $L_I = 200 \text{ mm}$ とした場合、DQ内でのビーム サイズは少々大きすぎるきらいがないではない。このため、もう一つの例として、 $L_I = 150 \text{ mm}$ として、CC入射部寸法を少々節約した案を示しておく。輸送行列とQ-レン ズ強度を表 8.2 に掲げる。

表 8.2. LI = 150 mm の CC(p = 175 mm) + DQ 系による QD 出口での輸送行列と Q-レンズ強度 (Q 電極長 = 100 mm) θ х Q 強度($E\rho = 38 \text{ kV}$) y φ -0.065 OU: 243.2 V/cm² -0.676 -0.104 2.131 х V QD: -272.1 V/cm² θ 0.952 -0.249 *φ* -3.002 0.217

図 8.3 は図 8.1 と同様に、系全体にわたって最外周軌道を示したものであり、図 8.4 は図 8.2 と同じ前提でQD出口以降の軸からの変位を計算したものである。 $L_{\rm I}$ = 200 mm の対応する図と較べて、Q-レンズ内のビームサイズは 3/4 程度に小さくできること が分かる。"角運動量"に関してはさらに若干大きく、 $C/r'_0 \leq 7.8$ mmになるが、ECR のプラズマ領域入射点($B_{\rm max}$ の点)でのビームサイズはほぼ変わらないことが分かる。



outermost trajectory for the geometry of prolonged exit arm LO $LI{=}0.15\text{m},$ rho=0.175m, L1=0.05m, LO=0.71m

図 8.3. $L_{\rm I}$ = 150 mm, ρ = 175 mm, $L_{\rm Q}$ = 50 mmとした場合のビーム最外周 (x_0 =12 mm, y_0 =8mm) 軌道座標。実線は初期角度 = 0、点線は初期角度幅=±25 mr とした場合に対応する。縦線は各 光学要素の出入口の位置を示す。黒:x,赤:y



図 8.4. 図 8.3 の場合のQD以降の軌道の軸からのずれ(左: B_{max} = 2T,右: B_{max} = 3T)。 曲線の色は、最外周軌道(x_0 = 12mm, y_0 = 8mm)について初期角度=0mrの場合(黒)、 θ_0 = ±25mr, φ_0 = ±25mrを考慮した場合、軸に対して最大角度(赤)、最小角度(ピンク)を持つ場合及び、軸 の周りに最大"角運動量"を持つ場合(緑)に対応する。縦線は直上の項目の位置を示す。

9. まとめ

以上、表面電離器から ECR 入射部までの Li イオンの輸送について概観した。表面 電離器に $x = \pm 12 \text{ mm}, y = \pm 8 \text{ mm}$ 程度の範囲で入射する編極 Li 原子線を、効率よく ECR イオン源に入射させることは可能であると結論して良いであろう。実際の輸送系の設 計において、上記の検討から導かれる注意点を以下にまとめておく。

1. 表面電離器からの Li イオン引き出し

表面電離器にらイオンの引き出しにおいては、グリッド等イオン引き出し機器による散乱を出来るだけ小さくする配慮が大切である。散乱角の広がりは、そのまま ECR イオン源に入射時のビームサイズにつながる。

一方、表面電離器からの引き出されるビームの角度、位置(の中心値)を調節でき る機構が望まれる。表面電離器に続く、イオン加速部の中心に軸を整合させるためで あるが、イオン引き出し電極の配置によっては、無視し難い大きさの位置ずれと角度 ずれが発生する可能性があり得る。

2. 加速部の構造

加速部に置いては、一本の加速管に大きなエネルギー利得を持たせて加速すること は得策ではない。加速後の x-, y-収束位置に大きな差異を生むためである。そのため に、3章では、加速部を 50 mm のドリフトスペースを挟んで 2 段加速とし(全長 100 mm を仮定)、前段、後段のエネルギー利得をそれぞれ 3.0、14/3 程度と小さくして、 全体利得も 14.0 程度に押さえた。(これにより、表面電離器からの引き出し電圧は、 最終加速エネルギーを 19 keV とすると、19/14 = 1.36 kV に設定することになる。)実 際には、加速部を 2 段以上の複数段加速とし、表面電離器の引出電圧も含めて、加速 エネルギー利得の配分を実験的に最適化するよう配慮することが必要かも知れない。

3. 静電偏向器による ECR イオン源への入射

加速された Li イオンは静電偏向器で 90° 偏向され、ECR イオン源に入射される。 ECR へのイオンビーム入射においては、ECR の「磁場入射点」でビーム幅を最小化 することが望ましい。磁場入射点は、現在予想される ECR 磁場分布の場合、磁気シ ールド外面からほぼ 210 mm 内部に入ったところである。入射において、ビーム幅に *x-*,*y*-方向のアンバランスが大きい場合、ECR 磁場内でビームサイズが大きくなること に注意が必要である。ビームの偏向系にはそうした注意を払った設計が必要である。

4. SC(spherical condenser) 偏向系による偏向器

SC による偏向器は x-, y-両方向に収束作用を持つため、ECR イオン源へのビーム入 射においては、補足的な収束要素を節約できる利点を持つ。実際、その可能性は本稿 でも示されたと言えるが、加速系とより注意深い整合を検討する必要があろう。もし、 その整合を無視するなら、補足的な収束要素が必要であり、静電Qレンズ1台の追加 で済ませることも出来そうである。同心球面電極の製作上の困難が欠点である。

5. CC(cylindrical condenser) 偏向系による偏向器

CC は同軸円筒電極からなり、製作は相対的に容易であるが、一方向にしか収束作 用を持たず、必然的に補足的な収束要素が必要である。上に示した検討からは、 CC+Q-doublet 系が運転のフレキシビリティに優れ、有力な候補である。本稿には今後 の設計の参考に、CC 上流部の geometry が異なる 2 つの例を示した。この例では、ECR イオン源のプラズマ入口で、ビームサイズは直径 8 mm 強となる。この減少を図るに は、偏向系の出口距離(偏向系出口-ECR 間距離)の短縮が最も有効であるが、直径 6 mm 程度が実際的な限界であろう。

6. 注意点

最後に、本稿に示した計算結果は、基本的には定性的結果と捉えるべきものである ことを注意しておきたい。特に加速部の近似には問題があり、過度に定量的資料とし て扱ってはならない。しかし、各光学パラメーターに対するビーム形状の依存性につ いては、およその傾向は示されていると考えて良いであろう。従って、磁場領域、加 速部、静電デフレクタの設計においては、この資料に示された必要性能を適切な調節 等によって達成できるようなフレキシビリティを持たせることに留意したい。